








	<h2 style="color: red;">FQP55N06</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP55N06</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 55A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP55N06.pdf 2.FQP55N06.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 36638 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP55N06
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 55A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	36638 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 55A (Tc) 133W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	133W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	55A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 mOhm @ 27.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	46nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1690pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP55N06 ist neu im Original, Suche FQP55N06 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP55N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP55N06: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP52N20 FAIRCHILD FAIRCHILD TO-220</p>	 <p>FQP55N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 55A TO-220</p>	 <p>FQP58N08 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 57.5A TO-220</p>	 <p>FQP50N06L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 52.4A TO-220</p>
 <p>FQP5N120BND FSC FQP5N120BND FSC</p>	 <p>FQP55N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 55A TO-220</p>	 <p>FQP50N08 FAIRCHILD FQP50N08 FAIRCHILD</p>	 <p>FQP58N08 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 57.5A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ FQP45N20A	↔ FQP46N15	⇒ FQP46N15	D FQP47N06	⇒ FQP47P06
⊣ FQP47P06	⊛ FQP47P06L	D FQP47P06_	⇒ FQP47P06_NW82049	⇒ FQP47P06_NW82049
⊛ FQP47P06_SW82049	⊣ FQP47P06_SW82049	⊛ FQP4N20L	↔ FQP4N20L	⇒ FQP4N60C
D FQP4N65C	⊛ FQP4N90C	⊣ FQP4N90C	⊛ FQP50N03	⇒ FQP50N03C
⇒ FQP50N06	↔ FQP50N06	⊛ FQP50N06L	⊣ FQP50N06L	⇒ FQP50N08
↔ FQP55N06	⇒ FQP55N10	D FQP55N10	⊛ FQP58N08	⊣ FQP58N08
⊛ FQP5N20L	D FQP5N20L	⇒ FQP5N50C	↔ FQP5N50C	⇒ FQP5N60C
⊣ FQP5N60C	⊛ FQP630TSTU	↔ FQP630TSTU	⇒ FQP65N06	⇒ FQP65N06
⊛ FQP6N40C	⊣ FQP6N40C	⊛ FQP6N40CF	D FQP6N40CF	⇒ FQP6N50C
↔ FQP6N50C	⊛ FQP6N60C	⊣ FQP6N60C	⊛ FQP6N80C	⇒ FQP6N80C

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited